

a 2007 0303

Invenția se referă la producerea semiconductorilor.

Procedeul de obținere a zonelor nanostructurale semiconductoare include depunerea pe una din fețele unui cristal semiconductor a unei măști cu o porțiune deschisă, corodarea electrochimică la anodizare într-o soluție apoasă de NaCl și înlăturarea măștii.

Rezultatul invenției constă în obținerea zonelor nanostructurale semiconductoare cu morfologia dirijată de concentrația soluției de NaCl și de parametrii electrici aplicați, utilizând soluția de NaCl care nu prezintă pericol pentru sănătatea personalului sau pentru mediul ambiant.

Revendicări: 1

Figuri.: 4